

钨钛合金靶 (WTi)

产品介绍

随着微电子科学技术的发展，对阻挡层薄膜的要求越来越高。大量研究表明Ti占10%~30%的WTi合金阻挡层已被成功地应用于Al、Cu和Ag布线技术，其中W的作用是阻挡扩散，而Ti的作用是阻止晶界扩散，同时改善阻挡层的耐腐蚀性能和粘结力。

因此钨钛靶对于扩散阻挡层有着重要的价值。钨钛合金溅射靶作为半导体芯片门电路接触层材料也得到广泛的应用。

	Ti ≤10wt%	>10wt% to ≤30wt%	Ti>30wt%
纯度	≥4N5 (99.995%)	≥4N5 (99.995%)	≥4N (99.99%)
钛含量	±0.5wt%	±0.5wt%	±1.0wt%
密度	≥ 99.5% 理论密度	≥ 99.5% 理论密度	≥ 99.5% 理论密度
平均晶粒尺寸	≤50μm	≤50μm	≤50μm
氧含量	≤1000ppm	≤2000ppm	≤2000ppm
尺寸	Φ340mm	Φ340mm	Φ340mm

*尺寸可按客户要求定制

回收服务

先导薄膜材料对原材料有着严格的控制，凭借独家的回收和提纯服务，可以确保WTi稳定的供应以及稳定的质量。先导薄膜可以通过完整的闭环回收服务来回收WTi残靶，从而可以降低客户成本，因此拥有独特的优势来服务客户。先导薄膜材料已经建立了一套完整的“租赁”体系，基于客户的使用率或信用记录，以及回收的钨价值，按每日价格来计算扣除回收费用。

先导薄膜材料已全面通过ISO9001，ISO14001，ISO14021和OHSAS18001认证。

